Перв. примен.	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
		Устро <del>й</del> ства		
	A1	VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN	1	
Перв.	A2	GeoS-5M φ. Geostar	1	
		Преобразователи неэлектрических величин		
	BL1	TEMD5510FX01	1	
	BL2	APA3010P3BT	1	
2		Конденсаторы		
Cnpab. Nº	<u>C1</u>	керам., чип 0603, NPO, 50B, 1nФ ±0.1nФ	1	
Ü	<i>C2</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	
	G	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%)	1	
	<i>C</i> 4	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16B,	1	
		47mkΦ ±10%)		
	<i>C5</i>	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%)	1	
	<i>C6</i>	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B,	1	не старше 1 года
		470мкФ ±20%, низк. имп.)		
и дата	<i>C</i> 7	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B,	1	
Подп. ц		1000mkΦ ±20%)		
	<i>C8</i>	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1	
Ση.		ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%)		
Инв. № дубл.	<i>C9-C24</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	58	
MH.	_	Микросхемы		
нв. №	DA1	МОСЗО63М (детектор нуля)	1	
Взам. инв.	DA2	TPS561201DDC φ. Texas Instruments	1	
		доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A)		
סנ		доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока ЗА)		
Подп. и дата	DA3	LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments	1	
Поди	и. 2	ВСАD.123456.001 ПЭЗ		1 ПЭЗ
7	Изм. Лист Разраδ. И	№ докум. Подп. Дата Ванов И.И. 17.06.2025	L	Лит. Лист Листов
Инв. № подл	Проверил П	empoв П.П. 17.06.2025 BoM Converter отладочный проект	AD	1 6
Инв. 1	<u> </u>	озина В.Н. 17.06.2025 Перечень элементов Пршков А.С. 17.06.2025		000 "НИИ БАЦА"

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	DD1	SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments	1	
	DD2	SCM3725ASA φ. MORNSUN	1	
	DD3	ECS-3225MV-250-CN φ. ECS Inc. (κβαρμ., 25MΓц ±25ppm, -40+85°C)	1	
		Элементы разные		
	EF1	У SMTSO-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)	1	
	ER1	FK 244 13 D2 PAK φ. Fischer Elektronik	1	
		Uspovisnika oguvenu o		
	FD1	Устройства защитные	1	
	FP1	MF-MSMF014 φ. Bourns (camoboccm., чип 1812, 140мA, 60B)	1	
	FU1	0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A <sup>2</sup> c, быстрый)	1	
	FU2	ZH242 (держатель)	1	
	FU3	ZH250 (держатель)	1	
	FU4	ZH242 (держатель)	1	
	FU5	ZH250 (держатель)	1	
	FV1	В72540T0400K062 ф. ТDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)	1	
מנ	FV2	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Вт [10/1000мкс],	1	
и дата		корпус SMB)		
Подп. и	FV3	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
		корпус SMB)		
δn.	FV4	GSOTO5C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23)	1	
Инв. № дубл.	FV5	CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)	1	
		Генераторы, источники питания		
HB. No	GB1	CR 1/2 AA S PCBD φ. VARTA	1	
Взам. инв.	GB2	BR-2325/2HAN	1	
	GB3	DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, , CR2032)	1	
מנ		доп. замена ВН-25F-1 ф. Adam Tech		
и дата		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices		
Подп.	GB4	ВН-25F-1 ф. Adam Tech (держатель, , CR2032)	1	
$\coprod$		доп. замена DS1092-04-B6P ф. Connfly		
одл.		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices		
Инв. № подл.	Изм. Лист	ВСАД. 123456. № докум. Подп. Дата	001 ПЭ	7) <i>Лист</i> 2

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
		Устройства сигнальные		
	HG1	СС56-12SRWA ф. Kingbright	1	
	HL1	КР-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)	1	
	HL2	КРТ-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL3	KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL4	KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)	1	
	HL5	KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL6	ХРСWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])	1	
	HL7	SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)	1	
	HL8	KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)	1	
	HL9	AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)	1	
	J1	Перемычка чип 0402	1	
		Реле		
	K1	RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity	1	
	K2	T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity	1	
	К3	RT214012 φ. TE Connectivity	1	
	K4	V23105A5476A201 φ. ΤΕ Connectivity	1	
1		Катушки индуктивности		
	L1	чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	1	
	L2	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓн ±30%, 1.5A)	1	
	L3-L5	чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	3	
	L6-L8	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓн ±30%, 1.5A)	3	
<del>                                     </del>	L9, L10	SRN6045TA-2R2Y φ. Bourns (2.2mkΓH ±30%, 6A)	2	
	L11	SRR0604-100ML φ. Bourns (10mkΓH ±20%, 1.3A)	1	
	L12	SRN6045TA-2R2Y φ. Bourns (2.2mkΓH ±30%, 6A)	1	
		Резисторы		
	R1	чип 0603, 10к0м ±5%	1	
		DCAD 403 / 5 / 6		/Jucm
	Изм. Лист		3456.UU111 <i>3</i> 3	

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	R2	чип 0603, 47к0м ±0.5%, ±25ppm/°C	1	
	R3	RV0805JR-071ML φ. YAGEO (чип 0805, 400B, 10κ0м ±5%)	1	
	R4-R6	чип 0603, 100к0м ±5%	3	
	R7, R8	чип 0603, 200к0м ±5%	2	
	R9-R12	чип 0603, 300к0м ±5%	4	
	R13	чип 0603, 470к0м ±5%	1	
	R14-R19	чип 0603, 1к0м ±1%	48	
	RK1	NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0m ±5%)	1	
	RK2	TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1	
	RP1	3006P-1-103 ф. Bourns (10к0м ±10%, , подстроечный, лин. хар-ка)	1	
-		Устройства коммутационные		
	SA1	CHS-01TA φ. Copal Electronics Inc.	1	
	SA2	SWD-08L	1	
	SA3	MS-22D18 (движковый)	1	
	SA4	GPTS203211B φ. CW Industries	1	
	SA5	SSSF012100	1	
, дата	SA6	PN12SHNAO3QE φ. C&K	1	
Подл. и о	SB1	DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный)	1	
dyōn.	Т1	Трансформатор HX1188NL ф. Pulse	1	
Инв. № дубл.		Диоды		
$\vdash$	VD1	BAS316 (100B, 250мА, корпус SOD-323)	1	
UHB. No	VD2	BAT20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323)	1	
Взам. L	VD3	BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1	
$\stackrel{\circ}{\vdash}$	VD4	BB545E7904 φ. Infineon	1	
<i>DU</i>	VD5	BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус S0T-23)	1	
Подп. и дата	VD6	BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
Подп.	VD7	BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мА, корпус SOT-23)	1	
iðn.				
Инв. № подл.	Изм. Лист	ВСАД. 123456. № докум. Подп. Дата	.001 ПЭ	/Jucm 4

	Поз. обозначе- ние	- Наименование	Кол.	Примечание
		Тиристоры		
	VS1		1	
	VS2	TYN412RG φ. STMicroelectronics (400B, 12A, 15mA)	1	
	VS3	ТММDB3TG ф. STMicroelectronics (двунаправ., 32B, 2A, 15мкА)	1	
	VS4	BTA24-600BWRG	1	
		_		
		Транзисторы	<u> </u>	
	VT1	ВСR108 (биполярный цифровой)	1	
	VT2	IRLML2030	1	
	VT3	BC817	1	
	VT4	ВСR158 (биполярный цифровой)	1	
	VT5	IRLML5103	1	
	VT6	BC807	1	
	VU1	Onmonapa LTV-357T	1	
	1			
дата		Соединители		
Подп. и дата	X1	15EDGRC-3.5-04P φ. Degson	1	
	X2	5035000993 φ. Molex	1	
		доп. замена 5035000991		
Инв. № дубл.	ХЗ	292303–1 φ. TE Connectivity	1	
Инв.				
No		Фильтры		
инв. 1	ZC1	WCM4532F2SF-142T2O-HI ф. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.	1	
Взам. инв.		(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)		
	ZF1	ММZ1608B102C ф. TDK (фер. бус., чип 0603, 1к0м ±25% [100МГц],	1	
та		600m0m, 300mA)		
Подп. и дата	ZQ1	FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ,	1	
Подг		1000m, -40+85°C)		
	ZQ2	ABS07–32.768КHZ-Т ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ррт, 12.5пФ,	1	
одл.		70кОм, -40+85°С)		
Инв. № подл.		DCAD 122/5/		/ucm
NH	Изм. Лист	ВСАД. 123456. ( № докум. Подп. Дата	כוו וטט ———	5

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Сопутствующие элементы		
	Батарея СR2032 (3В, 225мАч)	2	для GB3, GB4
	Предохранитель 0215002.MXP ф. Littlefuse (плавкий, цил. 5*20, 2A,	1	для FU3
	11.68A <sup>2</sup> c, 250B, медленный)		
	Предохранитель 520.517 ф. ESKA Erich Schweizer (плавкий, цил. 5*20,	4	для FU2, FU4; один запасной
	1A, O.2A <sup>2</sup> c, 25OB, быстрый)		
	Предохранитель 520.517 ф. ESKA Erich Schweizer (плавкий, цил. 5*20,	1	для FU5
	1A, O.2A <sup>2</sup> c, 25OB, быстрый)		
	Радиатор FK 231 SA 220 ф. Fischer Elektronik (TO220, 24K/Bm)	1	для VS4
	Соединитель 15EDGK-3.5-04P-14 ф. Degson	1	для X1
	BCAD.123456.0	 1/11 /	773 <i>Aucm</i>
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		6